

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种单层高活性二氧化钛薄膜的制备方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
115	0	0

**作者** 成会明, 王学文, 刘岗, 潘剑, 李峰 and 逯高清**发表日期** 2011-04-20**专利国别** 中国**专利类型** 发明专利**权利人** 中国科学院金属研究所**中文摘要** 本发明涉及在不同基体上形成单层高活性(001)晶面占优二氧化钛薄膜的制备方法,具体为一种通过湿化学过程在金属钛或钛合金基底上生长由单层二氧化钛颗粒组成的(001)晶面占优二氧化钛薄膜的方法,解决(001)占优二氧化钛粉体很难形成(001)面全部位于表面以及很难形成致密结合紧密薄膜的问题。将基体上装入有氢氟酸水溶液的反应釜中,经100~200°C加热处理6h~24h,可得到单层(001)晶面占优的二氧化钛薄膜。单层(001)晶面二氧化钛薄膜由锐钛矿和金红石相组成,锐钛矿和金红石相的比例从95:5到80:20,厚度约为10~1000nm,(001)晶面比例可控,比例从20%到91%,该薄膜具有很好的...**公开日期** 2011-04-20**语种** 中文**专利申请号** CN102021551A**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/66643>] **专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 成会明, 王学文, 刘岗, 潘剑, 李峰 and 逯高清. 一种单层高活性二氧化钛薄膜的制备方法. 2011-GB/T 7714 04-20.[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

© 版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号